

硅探测器和发射器

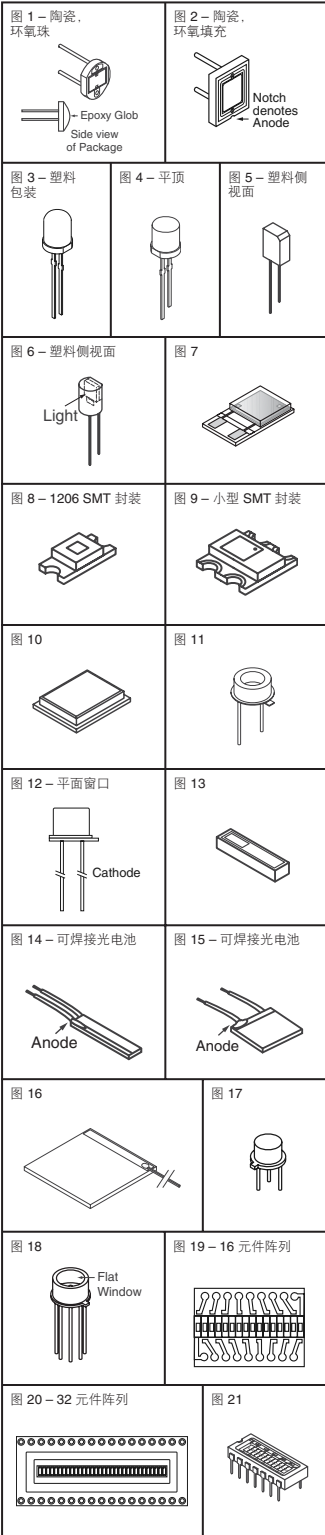
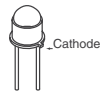
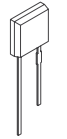








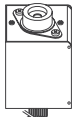



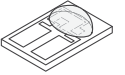

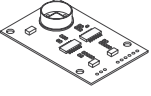

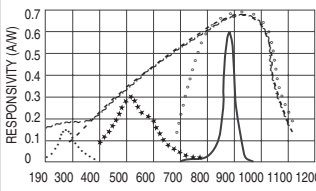


图	有效显示区域 (mm)	标准短路电流 (IsC) (uA)	最大暗电流 (Id) (nA)	灵敏度 波长 (nm)			标准结电容 (pF)	标准响应时间 (nS)	视角 (2x Theta)	Digi-Key 零件编号	单价			带卷†	
				最小	峰值	最大					1	25	100	数量	价格
蓝色增强型光敏探测器, 曲线 B															
1	17.74	235	50	350	950	1,100	100	20	120	PDB-C107-ND	19.74	12.77	11.96	—	—
2	100	1,300	30	350	950	1,100	300	25	120	PDB-C110-ND	95.91	73.06	69.58	—	—
3	7.95	110	30	350	950	1,100	60	16	120	PDB-C113-ND	18.87	15.41	14.44	—	—
4	1.55	60	30	400	950	1,100	6	10	30	PDB-C134-ND	3.47	2.06	1.73	—	—
5	4.10	67	30	400	950	1,100	18	50	61	PDB-C139-ND	5.23	3.23	2.85	—	—
6	29.02	400	25	350	950	1,100	200	18	120	PDB-C140-ND	17.90	12.77	12.27	—	—
7	4.10	150	30	400	950	1,100	10	15	120	PDB-C142-ND	5.23	3.23	2.85	—	—
8	8.02	90	15	400	950	1,100	10	15	120	PDB-C156-ND	5.34	3.16	2.66	—	—
9	9.00	145	30	400	950	1,100	10	50	120	PDB-C158-ND	5.34	3.16	2.66	—	—
10	7.95	110	10	350	950	1,100	60	100	—	PDB-C165-ND	17.41	11.27	10.56	—	—
11	0.74	10	10	400	950	1,100	15	50	140	PDB-C152SMCT-ND	3.76	2.22	1.87	3,000	1516.95/M
12	2.10	25	10	400	950	1,100	4	10	—	PDB-C154SMCT-ND	3.96	2.35	1.98	2,000	1606.18/M
13	7.67	90	30	400	900	1,100	15	20	—	PDB-C171SMCT-ND	4.96	2.93	2.47	1,000	2007.72
带有日光光谱的光敏探测器, 曲线 D															
1	1.55	60	30	700	950	1,100	6	10	30	PDB-C134F-ND	3.47	2.06	1.73	—	—
2	4.10	67	30	700	950	1,100	18	50	61	PDB-C139F-ND	5.23	3.23	2.85	—	—
3	4.10	150	30	700	950	1,100	18	50	40	PDB-C142F-ND	5.23	3.23	2.85	—	—
4	8.02	90	15	700	950	1,100	10	15	120	PDB-C156F-ND	5.34	3.16	2.66	—	—
5	9.00	145	30	700	950	1,100	10	50	120	PDB-C158F-ND	5.34	3.16	2.66	—	—
6	2.10	25	10	700	950	1,100	4	10	—	PDB-C154SMFCT-ND	3.96	2.35	1.98	—	—
蓝色增强型光敏探测器, 曲线 B															
11	1.17 x 2.64	40	300	350	—	1,100	340	190	65	PDB-V104-ND	66.18	54.73	51.32	—	—
12	17.74	200	0.80	350	950	1,100	2,000	1,000	120	PDB-V107-ND	15.81	10.23	9.59	—	—
13	100	1,200	0.333	350	950	1,100	10,000	2,000	120	PDB-V110-ND	92.24	70.27	66.93	—	—
14	7.95	80	0.50	350	950	1,100	800	750	120	PDB-V113-ND	18.33	11.86	11.12	—	—
15	3.15 x 5.69	230	550	350	—	1,100	2,000	190	63	PDB-V114-ND	73.11	60.47	56.70	—	—
紫外增强型光敏探测器, 曲线 A															
11	2.98	40	0.01	190	—	1,100	340	450	65	PDU-V104-ND	54.02	42.05	39.49	—	—
12	17.63	230	0.05	190	—	1,100	2,000	900	63	PDU-V114-ND	57.00	40.65	39.07	—	—
红色增强型可焊接光敏探测器, 曲线 B															
13	1.88 x 0.56	17	2.00	350	—	1,100	10	10	—	PDB-C601-1-ND	3.95	2.39	2.05	—	—
14	1.88 x 0.56	13	7.00	350	—	1,100	250	300	—	PDB-V601-1-ND	3.95	2.39	2.05	—	—
15	14.50	185	35	350	940	1,100	125	25	—	PDB-C607-2-ND	17.49	11.32	10.61	—	—
16	42.40	545	75	350	940	1,100	240	30	—	PDB-C609-2-ND	17.30	11.19	10.48	—	—
17	6.07 x 6.98	545	75	350	—	1,100	240	30	—	PDB-C609-3-ND	16.93	12.72	11.68	—	—
18	6.07 x 6.98	545	100	350	—	1,100	5,500	1,500	—	PDB-V609-3-ND	16.93	12.72	11.68	—	—
19	68.70	900	150	350	940	1,100	300	45	—	PDB-C612-2-ND	27.54	18.66	17.85	—	—
20	3.91 x 17.55	800	80	350	—	1,100	9,000	2,800	—	PDB-V612-2-ND	23.26	17.46	16.04	—	—
21	86.40	1,000	180	350	940	1,100	350	50	—	PDB-C613-2-ND	22.74	15.41	14.74	—	—
22	232.70	2,800	700	350	940	1,100	775	150	—	PDB-C615-2-ND	44.30	31.60	30.37	—	—
23	9.25 x 25.17	2,800	700	350	—	1,100	25,800	7,000	—	PDB-V615-2-ND	66.05	54.63	51.22	—	—
24	62.91	650	135	350	940	1,100	285	40	—	PDB-V617-2-ND	27.51	17.79	16.67	—	—
蓝色增强型双电池、象限和多元件探测器阵列, 曲线 B															
17	3.23±	75	2.00	350	950	1,100	15	8	72	PDB-C201-ND	33.20	23.68	22.76	—	—
18	1.61±	50	1.00	350	950	1,100	8	7	71	PDB-C203-ND	47.69	34.01	32.69	—	—
19	2.31±	28	5.00	350	950	1,100	40	800	—	PDB-C216-ND	102.50	78.08	74.36	—	—
20	1.47±	11	0.15	350	950	1,100	30	200	—	PDB-C232-ND	310.69	254.95	246.01	—	—
21	2.03 x 0.97±	—	2.70	350	—	1,100	28	190	—	SD219-51-03-301-ND	467.71	392.92	—	—	—
碲化硅 (SiC) 紫外光电二极管, 曲线 C															
17	0.08	0.04	1.00	200	280	400	21	5	87	PDU-S101-ND	31.98	21.67	20.73	—	—
镓铝砷 (AlGaAs) 红外光电二极管, 曲线 E															
17	0.77	6.0	2.00	840	880	940	90	1,000	65	PDI-G103-ND	34.07	24.31	23.36	—	—
22	0.77	22	2.00	840	880	940	90	1,000	40	PDI-G103L-ND	37.50	25.40	24.31	—	—
23	0.77	22	2.00	840	880	940	90	1,000	30	PDI-G104-ND	7.40	4.79	4.49	—	—
光敏硅光电二极管															
23	2.90	38	1.00	400	950	1,100	60	100	—	PDB-C168-ND	13.62	8.81	8.25	—	—
24	8.10	102	30	400	950	1,100	25	50	—	PDB-C169-ND	13.62	8.81	8.25	—	—
25	1.70	27	0.60	400	950	1,100	30	100	—	PDB-C170-ND	13.62	8.81	8.25	—	—
26	7.67	85	30	840	900	1,050	15	20	—	PDI-C172SMFCT-ND	4.96	2.93	2.47	1,000	2007.72
27	7.67	90	30	600	900	1,050	15	20	—	PDI-C173SMCT-ND	4.96	2.93	2.47	—	—
镓铝砷光电探测器															
17	.200	—	1.00	800	—	1,700	0.75	0.18 (max.)	—	SD004-11-41-211-ND	31.85	24.80	23.29	—	—
18	.200	—	5.00	800	—	1,700	0.95	0.23 (max.)	88	SD008-11-41-211-ND	77.26	63.91	59.92	—	—
19	.200	—	5.00	800	—	1,700	6	1.15 (max.)	88	SD012-11-41-211-ND	78.66	65.05	61.00	—	—
20	1.50	—	50	800	—	1,700	250	10.0 (max.)	113	SD060-11-41-211-ND	274.15	236.06	229.74	—	—
氮化镓 (GaN) 探测器															
11	0.076	1.0	100,000	200	—	365	24	10	61	PDU-G101A-ND	22.23	16.69	15.33	—	—
12	0.076	1.0	100,000	200	—	320	24	10	61	PDU-G102B-ND	25.72	19.30	17.73	—	—
24	—	.001	100,000	200	—	365	24	10	—	PDU-G105A-SM-ND	16.49	12.38	11.37	—	—
25	—	.001	100,000	200	—	320	24	10	—	PDU-G106B-SM-ND	17.39	13.06	11.99	—	—
硅雪崩光电二极管															
17	0.30	—	10	400	—	1,100	—	1	—	SD012-70-62-541-ND	201.23	171.09	161.18	—	—
18	0.90	—	30	400	—	1,100	—	2	—	SD036-70-62-531-ND	217.66	185.06	174.34	—	—
25	5.00	—	18	350	—	1,050	25	10	—	SD197-70-72-591-ND	1496.98	—	—	—	—
26	5.00	—	18	350	—	1,050	25	10	—	SD197-70-74-591-ND	1496.98	—	—	—	—
27	10	—	35	350	—	1,050	50	12	—	SD394-70-72-591-ND	2053.67	—	—	—	—
28	10	—	35	350	—	1,050	50	12	—	SD394-70-74-591-ND	2053.67	—	—	—	—
29	16	—	600	350	—	1,050	130	15	—	SD630-70-72-500-ND	2571.35	—	—	—	—
30	16	—	600	350	—	1,050	130	15	—	SD630-70-73-500-ND	2571.35	—	—	—	—
31	16	—	600	350	—	1,050	130	15	—	SD630-70-74-500-ND	2571.35	—	—	—	—
32	16	—	600	350	—	1,050	130	15	—	SD630-70-75-500-ND	2571.35	—	—	—	—
红色增强型硅光电二极管															
17	0.83 x 1.02	—	8.00	350	—	1,100	5.6	190	91	SD041-11-33-211-ND	34.41	26.79	25.15	—	—
18	0.50±	—	0.40	3											

硅探测器 and 发射器 (接上页)

图 22  Cathode	图 23 
图 24 	图 25 
图 26 	图 27 
图 28 	图 29 
图 30 	图 31 
图 32 	图 33 
图 34 	图 35 
图 36 	图 37 
图 38 	图 39 

曲线图



RESPONSIVITY (A/W)
WAVELENGTH (nm)

A(-) U.V. Enhanced Silicon Detectors
B(-) Blue Enhanced Silicon Detectors
C(.) Silicon Carbide U.V. Detectors
D(*) Daylight Filter Detectors
E(-) GaAlAs Photodiodes
F(*) CdS Photoconductive Cells (relative responsivity)

光电探测器 (接上页)

图	有效显示区域 (mm)	标准短路电流 (Isc) (uA)	最大暗电流 (Id) (nA)	灵敏度 波长 (nm)		标准 结电容 (pF)	标准 响应时间 (nS)	视角 (2x Theta)	Digi-Key 零件编号	单价			带卷† 数量	带卷† 价格
				最小	最大					1	25	100		
17	5.59 x 7.62	—	425	350	— 1,100	235	190	90	SD290-11-31-241-ND	68.45	56.61	53.08	—	—
18	9.65†	—	27	350	— 1,100	375	190	107	SD380-23-21-051-ND	192.54	163.70	154.21	—	—
17	—	—	31	350	— 1,100	390	190	—	SD385-24-21-041-ND	64.82	48.79	47.38	—	—
18	11.30	—	150	250	— 1,100	1,700	190	120	SD444-41-21-261-ND▲	554.16	490.20	—	—	—
2	1.00	—	120	350	— 1,100	1,700	190	120	SD445-11-21-305-ND	69.44	57.44	53.86	—	—
2	1.00	—	30	350	— 1,100	1,700	190	120	SD445-14-21-305-ND	69.44	57.44	53.86	—	—
蓝色增强型硅光电二极管														
29	5.31 x 8.10	500	15	350	— 1,100	120	190	79	PDB-C109-ND	67.56	55.88	52.40	—	—
30	0.33 x 0.33	1.5	2.00	350	— 1,100	5	190	—	PDB-C122-ND	—	48.52	45.56	—	—
7	1.17 x 2.64	25	10	350	— 1,100	7	190	—	PDB-C164-ND	33.52	26.10	24.50	—	—
17	2.54	—	6.40	350	— 1,100	87	190	82	SD100-12-22-021-ND	36.01	28.04	26.33	—	—
18	2.54	—	10	250	— 1,100	87	—	—	SD100-42-22-231-ND▲	142.89	121.49	114.45	—	—
27	2.54 x 2.18	—	—	—	—	—	—	—	SD112-45-11-221-ND▲	107.64	86.46	83.48	—	—
17	5.08	—	26	350	— 1,100	345	190	83	SD200-12-22-041-ND	65.08	49.00	47.59	—	—
17	5.08	—	26	350	— 1,100	345	190	95	SD200-12-22-241-ND	65.56	55.05	51.61	—	—
17	5.59 x 7.62	—	52	350	— 1,100	725	190	90	SD290-12-22-241-ND	68.45	56.61	53.08	—	—
31	11.28	—	52	350	— 1,100	725	190	95	SD444-12-12-171-ND	228.74	194.48	183.21	—	—
18	11.30	—	150	250	— 1,100	1,700	—	—	SD444-42-22-261-ND▲	554.16	490.20	—	—	—
紫外线增强型硅光电二极管														
17	2.54	—	6.50	250	— 1,100	87	190	90	SD100-13-23-222-ND	61.63	46.39	45.05	—	—
18	2.54	—	10	250	— 1,100	87	—	—	SD100-43-23-232-ND▲	142.89	121.49	114.45	—	—
17	5.08	—	30	250	— 1,100	345	190	95	SD200-13-23-242-ND	102.72	82.51	79.67	—	—
18	11.30	—	150	250	— 1,100	1,700	—	—	SD444-43-23-262-ND▲	554.16	490.20	—	—	—
硅雪崩式光电二极管模块														
32	10	—	—	350	— 1,050	—	—	—	SD197-70-72-661-ND	3745.66	—	—	—	—
32	10	—	—	350	— 1,050	—	—	—	SD197-70-74-661-ND	3745.66	—	—	—	—
32	10	—	—	350	— 1,050	—	—	—	SD394-70-72-661-ND	4150.60	3910.09	—	—	—
32	10	—	—	350	— 1,050	—	—	—	SD394-70-74-661-ND	4150.60	3910.09	—	—	—
塑料光电二极管														
33	0.61	10	10	700	— 1,100	25	6	48	PDB-C144-ND	4.36	2.78	2.50	—	—
33	0.43	10	30	400	— 1,100	5	6	48	PDB-C145-ND	4.36	2.78	2.50	—	—
34	0.43	2.0	30	400	— 1,100	1	6	120	PDB-C150SM-ND	8.13	4.89	4.66	—	—
6	2.84	120	30	400	— 1,100	30	50	120	PDB-C157-ND	4.46	2.69	2.31	—	—
35	2.65	90	30	400	— 1,100	15	20	120	PDB-C160SM-ND	4.12	2.50	2.15	—	—

†每个元件 §双电池 ◇四路 ▲探测器/放大器 †将 CT-ND 改为 TR-ND 即为带卷包装的零件编号。

血氧计元件

图	661nm				880/905/940nm				Digi-Key 零件编号	单价				
	标准 正向电压 (V)	反向 击穿 (V)	标准 峰值波长 (nm)	标准 上升/下降时间 (uS)	标准 正向电压 (V)	反向 击穿 (V)	标准 峰值波长 (nm)	标准 上升/下降时间 (uS)		1	25	100	250	
36	1.8	5	661	25	0.1/0.04	1.2	5	905	50	1.4/0.7	16.85	10.90	10.22	9.78
36	1.8	5	661	25	0.8/0.3	1.3	5	940	50	0.8/0.8	66.05	54.63	51.22	49.98
37	1.8	5	661	25	0.8/0.8	1.3	5	940	50	0.8/0.8	17.85	11.55	10.82	10.36
37	1.8	5	661	21	0.1/0.04	1.3	5	880	50	0.8/0.8	66.05	54.63	51.22	49.98
36	1.8	5	661	21	0.1/0.04	1.2	5	880	50	0.8/0.8	66.05	54.63	51.22	49.98

光束位置探测器

图	有效区域	灵敏度 波长 (nm)		Digi-Key 零件编号	单价		
		最小	最大		1	25	100
38	2.79†	250	— 1100	BPD-8-L-ND◇	533.55	—	448.23

†每个元件 ◇四路

大功率红外发射源

图	标准 正向电压 (V)	恒定 正向电流 (mA)	标准 输出功率 (mW)	射束角 (2x Theta)	标准 峰值波长 (nm)	Digi-Key 零件编号	单价			
							1	25	100	250
12	1.5	100	22	80	880	PDI-E801-ND	24.21	16.40	15.70	15.09
22	1.5	100	24	40	880	PDI-E802-ND	24.21	16.40	15.70	15.09
22	1.5	100	24	8	880	PDI-E803-ND	24.21	16.40	15.70	15.09
22	1.5	100	32	80	880	PDI-E804-ND	15.25	9.87	9.25	8.85
22	1.5	100	24	5	880	PDI-E805-ND	23.28	15.77	15.09	14.51
3	1.5	100	30 (最大值)	35	880	PDI-E808-A-ND	18.46	13.85	12.72	12.36
3	1.6	100	90	—	880	PDI-E809-ND	18.46	13.85	12.72	12.36
22	1.5	180	15	—	880	PDI-E813-ND	71.35	59.01	55.33	53.98
22	1.7	100	2.7	—	850	PDI-E825-ND	48.20	37.52	35.23	34.02
34	1.2	100	0.7	—	940	PDI-E940SM-ND	18.46	13.85	12.72	12.36

光电池

图	尺寸 D (mm)	电池电阻†				标准 峰值波长 (nm)	标准 上升/下降时间 (ms)	Digi-Key 零件编号	单价					
		10 Lux @ 2856K		暗					1	25	100	250		
		最小值 (KΩ)	最大值 (KΩ)	最小值 (KΩ)	SEC									
39, 曲线 F	11.00	8	16	0.3	—	520	55/25	PDV-P5001-ND	4.69	2.77	2.34	2.21		
		12	30	0.5	10				4.69	2.77	2.34	2.21		
		12	58	1	—				4.69	2.77	2.34	2.21		
	7.20	4	20	0.5	10	520	55/20	PDV-P7002-ND	3.90	2.36	2.03	1.93		
			3	11	0.2				—	3.47	2.06	1.73	1.64	
			40	120	1				—	3.47	2.06	1.73	1.64	
		5.10	4	11	0.15	—	520	60/25	PDV-P8101-ND	3.47	2.06	1.73	1.64	
				9	20	0.3				10	3.47	2.06	1.73	1.64
				16	33	0.5				—	2.89	1.75	1.51	1.44
	4.20	4	11	0.3	—	520	60/25	PDV-P9001-ND	2.81	1.67	1.40	1.33		
			9	20	0.5				10	2.81	1.67	1.40	1.33	
			11	20	0.5				—	2.81	1.67	1.40	1.33	
16		33	1	—	—	520	60/25	PDV-P9003-ND	2.81	1.67	1.40	1.33		
			23	33	1				—	2.81	1.67	1.40	1.33	
			27	60	2				—	2.81	1.67	1.40	1.33	
50		94	2.5	—	—	520	60/25	PDV-P9004-ND	2.81	1.67	1.40	1.33		
			48	140	20				10	2.81	1.67	1.40	1.33	
			80	200	5				—	2.81	1.67	1.40	1.33	
10	100	1	—	—	520	60/25	PDV-P9007-ND	2.81	1.67	1.40	1.33			
		10	200	20				—	2.81	1.67	1.40	1.33		
		20	45	1				10	2.81	1.67	1.40	1.33		
5	20	5	—	—	520	70/15	PDV-P9200-ND	2.81	1.67	1.40	1.33			
		10	50	5				—	2.81	1.67	1.40	1.33		
		15	20	20				—	2.81	1.67	1.40	1.33		

†光电池光谱配准 100 至 500 Lux.

全部产品均以新加坡元计价。